




|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB025N10N3GE8187ATMA1</p>   |
|   | <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>  |
|  | <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 180A TO263-7</p>   |
|   | <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB025N10N3GE8187ATMA1.pdf</a></p> |
| <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>                                | <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>   |
| <p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>  | <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>  |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>                |  |

**Spezifikationen**

|  |  |
|--|--|
| Teilenummer                                      | IPB025N10N3GE8187ATMA1                           |
| Hersteller                                       | International Rectifier (Infineon Technologies)  |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 100V 180A TO263-7                    |
| Kategorie  | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus                                       | Require For Quote & Check Stock                  |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 3.5V @ 275µA                                     |
| Vgs (Max)  | ±20V   |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)                             |
| Supplier Device-Gehäuse                          | PG-TO263-7                                       |
| Serie  | OptiMOS™   |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 2.5 mOhm @ 100A, 10V                             |
| Verlustleistung (max)                            | 300W (Tc)  |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)                                 |
| Verpackung / Gehäuse                             | TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab)                  |
| Andere Namen                                     | IPB025N10N3 G E8187                              |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 175°C (TJ)                               |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount                                    |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)        | 1 (Unlimited)                                    |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant                       |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 14800pF @ 50V                                    |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 206nC @ 10V                                      |
| Typ FET  | N-Channel  |
| FET-Merkmal                                      | -  |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 6V, 10V  |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 100V   |
| detaillierte Beschreibung                        | N-Channel 100V 180A 300W (Tc) Surface Mount PG-  |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 180A   |

IPB025N10N3GE8187ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB025N10N3GE8187ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB025N10N3GE8187ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB025N10N3GE8187ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p><b>IPB026N06N(026N06N)</b><br/>INFINEON<br/>IPB026N06N(026N06N)<br/>INFINEON</p> |  <p><b>IPB027N10N3G</b><br/>INFINEO<br/>IPB027N10N3G INFINEO</p> |  <p><b>IPB025N10N3 G</b><br/>Infineon Technologies<br/>MOSFET N-CH 100V 180A TO263-7</p>                              |  <p><b>IPB025N10N3GATMA1</b><br/>International Rectifier (Infineon Technologies)<br/>MOSFET N-CH 100V 180A TO263-7</p> |
|  <p><b>IPB026N06N</b><br/>INFINEO<br/>IPB026N06N INFINEO</p>                                      |  <p><b>IPB025N08N3G</b><br/>INFINEO<br/>IPB025N08N3G INFINEO</p> |  <p><b>IPB025N08N3GATMA1</b><br/>International Rectifier (Infineon Technologies)<br/>MOSFET N-CH 80V 120A TO263-3</p> |  <p><b>IPB027N10N3 G</b><br/>INFINEON<br/>IPB027N10N3 G INFINEON</p>   |

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

|  |   |                                      |                                   |   |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| IPB025N10N3GE8187ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) | IPB025N10N3GE8187ATMA1 Datenblatt       | IPB025N10N3GE8187ATMA1- Datenblätter | IPB025N10N3GE8187ATMA1 PDF        | International Rectifier (Infineon Technologies)<br>IPB025N10N3GE8187ATMA1 |
| IPB025N10N3GE8187ATMA1 Electronic                                      | IPB025N10N3GE8187ATMA1- Komponenten     | IPB025N10N3GE8187ATMA1-Verteiler     | IPB025N10N3GE8187ATMA1-Bild       | IPB025N10N3GE8187ATMA1-Teil   |
| IPB025N10N3GE8187ATMA1 Aktie   | IPB025N10N3GE8187ATMA1 Inventar         | IPB025N10N3GE8187ATMA1 Neu           | IPB025N10N3GE8187ATMA1 Hersteller | IPB025N10N3GE8187ATMA1 Bild   |
| IPB025N10N3GE8187ATMA1 RFQ   | IPB025N10N3GE8187ATMA1 Online bestellen |                                      | IPB025N10N3GE8187ATMA1 Original   | IPB025N10N3GE8187ATMA1 garantiert   |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited